



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN22981X

Issue Date: 03 Dec 2019

Title of Change:	Qualification of Field Stop 4(FS4) Trench IGBT Technology in ON Semiconductor Aizu, Japan.	
Proposed First Ship date:	03 Jun 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Bokyun.Seo@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	No changed	
Change Category:	Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Aizu, Japan	None	
Description and Purpose:		
ON Semiconductor would like to inform its customers of additional wafer fabrication facility for Field Stop 4 TIGBT technology in ON Semiconductor Aizu (AFSM), Japan for the devices listed in this IPCN. All products listed here will be dual sourced from its current wafer fab facility in ON Semiconductor Bucheon, Korea and ON Semiconductor Aizu, Japan.		
	Before Change Description	After Change Description
Wafer Fab Site	Bucheon, Korea	Bucheon, Korea and ON Semiconductor Aizu, Japan
There is no product marking change as a result of this change.		

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME : FGH75T65SQD-F155

PACKAGE : TO247

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
HAST	JESD22-A101	Ta = 130°C, RH=85%, Pressure: 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
HTGB	JESD22-A108	Tj = 1 Maximum rated junction temperature for 1008 hrs, Vgss Bias = 100% of max rated	1008 Hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C; for 1000 cycles (JA104)	1000 cyc
UHASt	JESD22-A118	Ta=130°C/85% RH/18.8 PSIG for 96 hrs (JA118)	96 hours
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff 5.0 min	6000 cyc
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	
DPA	AEC Q101-004	Post 1008 hours H3TRB (+PC) or 96 hrs HAST (+PC)	
DPA	AEC Q101-004	Post 1000 cyc TC (+PC)	

QV DEVICE NAME : FGY75T95SQDT & FGY75T95LQDT

PACKAGE : TP247

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hours
HTGB	JESD22-A108	Temp = 175C, bias = 100% Vgss	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
HAST	JESD22-A101	Ta = 130°C, RH=85%, Pressure: 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C; for 1000 cycles (JA104)	1000 cyc
UHASt	JESD22-A118	Ta=130°C/85% RH/18.8 PSIG for 96 hrs (JA118)	96 hours
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff 5.0 min	6000 cyc
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	
DPA	AEC Q101-004	Post 1008 hours H3TRB (+PC) or 96 hrs HAST (+PC)	
DPA	AEC Q101-004	Post 1000 cyc TC (+PC)	

Estimated date for qualification completion: 10 January 2020

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FGAF20S65AQ	FGH75T65SQD-F155
FGAF30S65AQ	FGH75T65SQD-F155
FGAF40S65AQ	FGH75T65SQD-F155
FGH40T65UQDF-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH40T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH50T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH60T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQDNL4	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQDT-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQDTL4	FGH75T65SQD-F155
FGHL50T65SQ	FGH75T65SQD-F155
PCFG40T65SQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG50T65SQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG60T65SQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG75T65LQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG75T65SQF	FGH75T65SQD-F155
FGHL40S65UQ	FGH75T65SQD-F155
FGA40T65UQDF	FGH75T65SQD-F155
FGHL75T65MQD	FGH75T65SQD-F155
FGY75T95LQDT	FGY75T95LQDT
FGY75T95SQDT	FGY75T95SQDT
PCFG75T95SQGW	FGY75T95SQDT

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22981X

発行日: 03 Nov 2019

変更件名:	オン・セミコンダクター会津 (日本) におけるフィールド・ストップ 4(FS4)トレンチ IGBT テクノロジーの認定	
初回出荷予定日:	3 June 2020 (またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前)	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Bokyun.Seo@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	変更なし	
変更カテゴリ:	ウエハファブの変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Aizu, Japan	なし	
説明および目的:		
オン・セミコンダクターは、本 IPCN に記載された製品であるフィールド・ストップ 4 TIGBT テクノロジーのウエハー工場として、オン・セミコンダクター会津 (AFSM、日本) の追加認定をお客様にお知らせいたします。 ここにリストされるすべての製品は、現在のウエハー工場である韓国富川市と日本のオン・セミコンダクター会津からのデュアルソースとなります。		
	変更前の表記	変更後の表記
ウエハ製造拠点	Bucheon, Korea	Bucheon, Korea and ON Semiconductor Aizu, Japan
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



認定計画:

デバイス名: FGH75T65SQD-F155

パッケージ: TO247

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
HAST	JESD22-A101	Ta = 130°C, RH=85%, Pressure: 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
HTGB	JESD22-A108	Tj = 1 Maximum rated junction temperature for 1008 hrs, Vgss Bias = 100% of max rated	1008 Hrs
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C; for 1000 cycles (JA104)	1000 cyc
UHAST	JESD22-A118	Ta=130°C/85% RH/18.8 PSIG for 96 hrs (JA118)	96 hours
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff 5.0 min	6000 cyc
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	
DPA	AEC Q101-004	Post 1008 hours H3TRB (+PC) or 96 hrs HAST (+PC)	
DPA	AEC Q101-004	Post 1000 cyc TC (+PC)	

デバイス名: FGY75T95SQDT & FGY75T95LQDT

パッケージ: TO247

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = 175°C, bias = 100% of rated V	1008 hours
HTGB	JESD22-A108	Temp = 175C, bias = 100% Vgss	1008 hours
HTSL	JESD22-A103	Ta = 175°C	1008 Hrs
HAST	JESD22-A101	Ta = 130°C, RH=85%, Pressure: 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC	JESD22-A104	Ta = -65°C to +150°C; for 1000 cycles (JA104)	1000 cyc
UHAST	JESD22-A118	Ta=130°C/85% RH/18.8 PSIG for 96 hrs (JA118)	96 hours
IOL	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff 5.0 min	6000 cyc
RSH	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	
DPA	AEC Q101-004	Post 1008 hours H3TRB (+PC) or 96 hrs HAST (+PC)	
DPA	AEC Q101-004	Post 1000 cyc TC (+PC)	

認定完了予定日: 10 January 2020



影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FGAF20S65AQ	FGH75T65SQD-F155
FGAF30S65AQ	FGH75T65SQD-F155
FGAF40S65AQ	FGH75T65SQD-F155
FGH40T65UQDF-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH40T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH50T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH60T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQD-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQDNL4	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQDT-F155	FGH75T65SQD-F155
FGH75T65SQDTL4	FGH75T65SQD-F155
FGHL50T65SQ	FGH75T65SQD-F155
PCFG40T65SQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG50T65SQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG60T65SQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG75T65LQF	FGH75T65SQD-F155
PCFG75T65SQF	FGH75T65SQD-F155
FGHL40S65UQ	FGH75T65SQD-F155
FGA40T65UQDF	FGH75T65SQD-F155
FGHL75T65MQD	FGH75T65SQD-F155
FGY75T95LQDT	FGY75T95LQDT
FGY75T95SQDT	FGY75T95SQDT
PCFG75T95SQGW	FGY75T95SQDT